**027\_Body\_Effect**

1. 문턱전압의 변화

- Body는 채널 하부 실리콘 기판 자체 영역(Substrate, Bulk) → Body = Wafer라고 생각해도 무방

- Body 전압의 변화에 따라 문턱전압의 변화 유도

2. N형 MOSFET 기준

- Drain, Source 전압 = 0V / Gate 전압 > 0V(단, 문턱전압 이하) 설정

- Back Bias 증가 : Body 전압 < 0V → 전극과 Body의 PN접합 역방향 Bias로 공핍층 증가 → 높은 Gate 문턱전압(공핍층을 밀어내고 소수 캐리어를 모아야 하므로)

- Back Bias 감소 : Body 전압 > 0V → 전극과 Body의 PN접합 순방향 Bias로 공핍층 감소 → 낮은 Gate 문턱전압

3. Body Effect

